

	<p><b>SQV120N10-3M8_GE3</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> SQV120N10-3M8_GE3</p>
	<p><b>Hersteller / Marke:</b> Electro-Films (EFI) / Vishay</p>
	<p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 100V 120A TO262-3</p>
	<p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SQV120N10-3M8_GE3.pdf</a></p>
	<p><b>RoHs Status:</b></p>
	<p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p>
	<p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>

Spezifikationen

Teilenummer	SQV120N10-3M8_GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 120A TO262-3
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	3.5V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-262-3
Serie	Automotive, AEC-Q101, TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	3.8 mOhm @ 20A, 10V
Verlustleistung (max)	250W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-262-3 Long Leads, I <sup>2</sup> Pak, TO-262AA
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	7230pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	190nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 100V 120A (Tc) 250W (Tc) Through Hole TO-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	120A (Tc)

SQV120N10-3M8\_GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SQV120N10-3M8\_GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SQV120N10-3M8\_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SQV120N10-3M8\_GE3 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>BUK9509-40B,127</b> Nexperia MOSFET N-CH 40V 75A TO220AB</p>	 <p><b>SQV453226T-331K-S</b> Original 4532</p>	 <p><b>SQV453226T-102K-N</b> Original 4532</p>	 <p><b>SQV120N06-4M7L_GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 60V 120A TO262-3</p>
 <p><b>DMN10H170SFDE-7</b> Diodes Incorporated MOSFET N-CH 100V 2.9A 6UDFN</p>	 <p><b>SQV453226T-271J(LQH43MN271J01L)</b> YAGEO YAGEO 0.5KREEL</p>	 <p><b>SQV453226T-102J-N</b> Original 4532</p>	 <p><b>IPW60R075CPFKA1</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 650V 39A TO-247</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SQV120N10-3M8_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SQV120N10-3M8_GE3 Datenblatt	SQV120N10-3M8_GE3-Datenblätter	SQV120N10-3M8_GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay
SQV120N10-3M8_GE3 Electronic	SQV120N10-3M8_GE3-Komponenten	SQV120N10-3M8_GE3-Verteiler	SQV120N10-3M8_GE3-Bild	SQV120N10-3M8_GE3-Teil
SQV120N10-3M8_GE3 Preis	SQV120N10-3M8_GE3 Hersteller	SQV120N10-3M8_GE3 Bild	SQV120N10-3M8_GE3 Aktie	SQV120N10-3M8_GE3 Inventar
SQV120N10-3M8_GE3 Neu	SQV120N10-3M8_GE3 Original	SQV120N10-3M8_GE3 garantiert	SQV120N10-3M8_GE3 RFQ	SQV120N10-3M8_GE3 Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited